EUROPEAN PATENT OFFICE

Appl. No. 09/783,034 Doc. Ref. AP1

Pat nt Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

07283336

PUBLICATION DATE

27-10-95

APPLICATION DATE

05-04-94

APPLICATION NUMBER

06067154

APPLICANT: TOPPAN PRINTING CO LTD;

INVENTOR:

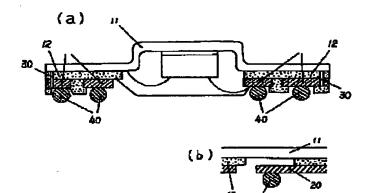
TOKI SOTARO;

INT.CL.

H01L 23/12

TITLE

CHIP CARRIER



ABSTRACT :

PURPOSE: To improve cooling property and connection reliability by providing a spherical pad for making connection to an external circuit at each end.

CONSTITUTION: A lead member 20 is aligned and overlapped on the surface at the side of an insulation base (adhesive sheet) 12 provided at a metal plate 11 for mounting a chip and both are heated to 180°C and are laminated while applying 2-5kg/cm² pressure and are cooled after approximately 30 minutes and then are taken out. A hole 30 for connection is formed in advance at a part where the lead member 20 and the conductor part of the metal plate 11 for mounting a chip need to be electrically connected, both are laminated, a conductive paste including copper powder is filled into the hole 30, and the conductive paste is heated at 150°C for 30 minutes to cure the paste. The electrode on the chip and the lead member 20 are electrically connected by a wire bonder with a gold wire whose diameter is 30µm. The ground electrode on the chip is connected to the conductor member of the metal plate 11 for mounting the chip.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-283336

(43)公開日 平成7年(1995)10月27日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 L 23/12

H 0 1 L 23/ 12

L

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

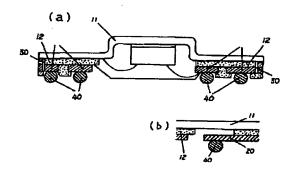
(21)出願番号	特顧平6-67154 ·	(71)出願人 000003193
(22)出願日	平成6年(1994)4月5日	凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号
		(72)発明者 大房 俊雄
		東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版 刷株式会社内
		(72)発明者 塚本 健人
		東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版
		刷株式会社内
		(72)発明者 土岐 荘太郎
		東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版
		刷株式会社内

(54)【発明の名称】 チップキャリア

(57)【要約】

【目的】QFP型の半導体装置の製造設備をそのまま使用でき、従来のBGAより放熱性・接続信頼性の高い、新規なBGA型のチップキャリアを提供する。

【構成】チップ搭載用金属板の表面に、搭載部を除く形状に設けられた絶縁性シートを介して、所定の導体パターンよりなるリードが、半導体集積回路素子と接続される多数の始端より略放射状に外側に延びており、それらの末端が前配絶縁性基材の表面に略マトリクス状に配置されており、個々の前配末端には、外部回路との接続用の球状パッドが設けられている。



20

合わせ、両面顕光機 (HMW532D (商品名);オー ク (株) 製) にセットして、紫外線を約100mJ/cm2 照 射して、被照射部のレジストを現像液に不溶な状態に変 化させた。

【0030】レジスト・パターンは、成形後のリード・ パターンであり、チップと接続される多数の始端より咯 放射状に外側に延びており、それらの末端が略マトリク ス状に配置されており、必要に応じて、前記太端部が、 他の導体部より幅が広く、円形または多角形もしくはこ れに類似する形状となるようにパターニングする。

【0031】さらに、5%のトリエタノールアミン溶液 に浸漬し、10秒に1~2回の割合で揺動しながら2分 後に取り出し、現像液が表面に残らなくなるまで水で洗 浄した。さらに、純水で洗浄し、約40℃の乾燥空気を 吹きつけて水分を完全に飛ばし、表面を乾燥させた。そ の後、前記材料を、予め110℃に加熱しておいたオー プンに入れ、エッチング液で剥離したり溶解したりしな いようにレジストを十分に硬化させた。

【0032】(3) リードの成形(金属材料のエッチング

前記材料に、50℃の塩化第二鉄をスプレーで吹きつ け、レジストで覆われていない部分の鉄ーニッケル合金 を腐食させて除去した。材料表面に付着した塩化第二鉄 液を良く落としてから、約30℃の水をスプレーで吹き つけて塩化第二鉄液を完全に洗い流した。次いで、乾燥 空気を吹きつけて表面に付着した水分を飛ばした後、5 0℃に加熱した水酸化ナトリウム5%溶液に約2分間浸 沿し、レジストを膨潤させて除去し、30℃の水で良く 洗浄して乾燥させた。以上、(1)~(3)の工程により、 例えば図2に示すようなリード部材20を得た。

【0033】(4) チップ搭環用金属板の成形 上配とは別に、厚さ約0.5㎜の銅板の中央部の縦横約 20㎜を除いた部分を絞り加工して、深さ約0.7㎜の 窪みを形成し、チップ搭載部とした。

【0034】次に、窪み部分の外側部に、絶縁性シート となる厚さ60μmのエポキシ系接着シート(YEF-040 (商品名) ; 三菱油化 (株) 製) を寒ね、約10 0℃の熱板で2~5kg/cm² の圧力を約10秒間加え て、チップ搭载部と絶縁性基材とを貼り合せ、チップ搭 **環用金属板11を得た。(図1参照)**

【0035】この際、エポキシ系接着シート(絶録性基 材) を任意のパターン状とすることによって、後工程に おいて、リード部材と稂層した場合に、リード・パター ンの末端部の接続用パッド部分がチップ搭貸用金属板と **離間(シートの厚さ分)した构成とすることができる。**

【0036】(5) チップキャリアの製造(以下、図1参

チップ搭载用金属板11に設けられた絶縁性基材(接着シ ート) 12側の面に、リード部材20を位置合わせして重 ね、そのまま $2\sim5\,{\rm kg/cm^2}\,$ の圧力を加えながら、 $1\,8\,$ 50 チップ上の電접とリード部材20との電気的な接腕を、ワ

0℃に加熱し、両者を貼り合わせた。約30分後、冷却 して取り出した。

【0037】リード部材20とチップ搭载用金属板11の導 体部とを電気的に接続させることが必要な箇所には、予 め接続用の穴30を形成しておいた。両者の貼り合わせ 後、この穴30に銅粉を含む導電ペースト(NF2000 (商品名) ; タツタ電線 (株) 製) を充填し、150℃ で30分間加熱してペーストを硬化させた。

【0038】(6) 接続用パッドの形成

次に、リード部材20のリード末端部以外を覆うための絶 **&性樹脂(プロピマー52(商品名);チパガイギー** 製)を、リード部材20のある面に塗布し、そのまま室温 で乾燥させた。

【0039】次いで、80℃で約10分間加熱し、樹脂 中に含まれる溶剤を揮発させ、表面に塗布したレジスト がベトつかなくなるまで乾燥させた。

【0040】その後、開口部分がリード部材20のリード 末端部に対応するパターンマスクを重ね合わせ、両面露 光機 (HMW532D (商品名);オーク (株) 製) に セットして、紫外線を約7000mJ/cm² 照射して、 被照射部の樹脂を現像液に不溶な状態に変化させた。次 いで、現像処理によって、紫外線の当たらなかった部分 の樹脂を溶解させて除去した。140℃で30分間加熱 して樹脂を完全に硬化させた。

【0041】樹脂を除去した部分にディスペンサで、は んだクリーム(SQ-10320SHZ(商品名); (株) タムラ製作所製) を詮布し、IRリフロー装置 (RF-330(商品名);日本パルス技研(株)製) で230℃、約1分間加熱してはんだクリームを溶融さ せた。このまま冷却し洗浄することによって、球状のは んだパッド40をリード部材20の導体パターンの外部端子 上に形成した。

【0042】この際、はんだパッドを複層构成とするこ とも任意である。例えば、錫、錫-鉛合金、金とこれら の金属を主成分とする合金のうち、2種以上の金属を和 **層した构成とし、前記末端部側に金を含む合金のような** 高融点の金属を配置し、外側に錫または錫一鉛合金を配 置することで、外側のはんだは接続に寄与し、内側のは んだは接続の際の加熱・加圧によってもつぶれない関性 を有するものであり、隣り合うリードとの短絡が防止さ れる。

【0013】(7) チップの搭環

次に、チップ搭载用金属板11の中央部に形成した窪み (チップ搭贷箇所) に銀ペースト (CRN-1022 (商品名) ;住友ペークライト(株) 製)を塗布し、チ ップを乗せ、200℃で30分間加熱することにより、 銀ペーストを硬化してチップを固定させた。これらの一 連の操作はダイボンディング装置で行った。

【0011】(8) 半導体パッケージの製造

7

イヤーポンダを用いて直径 $30\mu m$ の金線で行った。また、チップトのグランド電極は、チップ搭載用金属板11の導体部と接続させた。

【0045】なお、電気的に接続できる方法であれば、 ワイヤーポンディングによる方法に限定する必要はな く、導電ペーストによる方法やバンプを使用する方式で も良い。

【0016】金線と半導体素子を保護するため、封止用 樹脂を任意の方法(例えば、ディスペンサやトランスファ・モールド)で除布し、180℃で30分間加熱して 10 樹脂を硬化させ、その後、フレームとの接続部を金型で 切断して半導体パッケージを得た。

[0047]

【発明の効果】QFP型の半導体装置の製造設備をそのまま使用でき、PGA型の半導体装置より安価で、既存のBGA型の半導体装置より放熱性・接続信頼性の高い、新規なBGA型の半導体装置を達成するようなチッ

プキャリアが提供された。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のチップキャリアの断面説明図。

【図2】本発明のチップキャリアを形成するリード部材の一例を示す平面図。

8

【図3】従来のチップキャリア(QFP)の説明図。

【図4】従来のチップキャリア (PGA) の説明図。

【図 5】従来のBGA方式のチップキャリアのの説明 図。

10 【符号の説明】

10…チップキャリア

11…チップ搭載用金属板

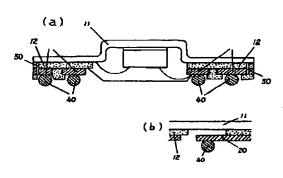
12…絶縁性基材

20…リード部材

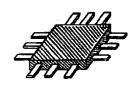
40…はんだパッド

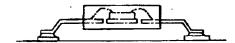
50…BGA型の半導体パッケージ

[図1]

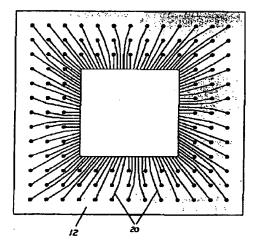


[図3]





[図2]



【図4】



